

WS331

散件包装 (300件/包)

双极锁存型霍尔效应集成电路芯片

双极锁存型霍尔效应集成电路芯片WS331是一种InSb传感器+Si-ASIC混合锁存型集成电路,具有超高灵敏度和宽工作电压范围内的低温漂移。

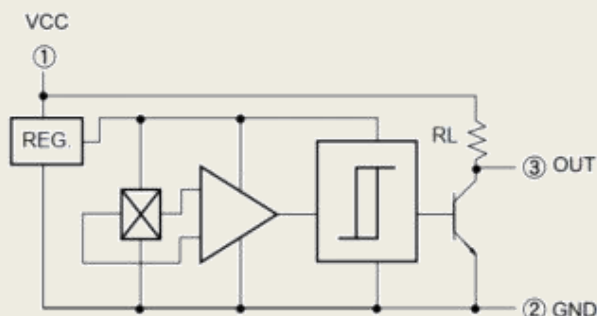
● 特点

- 超高灵敏度，典型Bop 30Gs
- 工作点在-30 ~120 温度范围内的低温漂移
- 宽工作电压范围2.3V~40V
- 内置上拉电阻

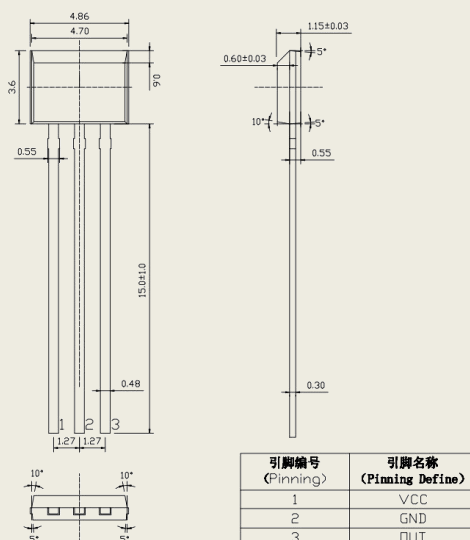
● 应用领域

- 流量传感
- 无刷直流电机转子的位置传感
- 角度和速度感应
- 行程传感

● 功能框图



● 封装外形图 (单位 : MM)



● 绝对最大额定值 (25)

● 推荐的操作条件

参数	符号	范围	单位
电源电压	VCC	-0.3~40	V
工作电压	Topr	-40~150	°C
储存温度	Tstg	-40~150	°C

参数	符号	最小	最大	单位
电源电压	VCC	2.3	18	V
操作温度	Topr	-30	120	°C

附注:强调超出“绝对最大额定值”所列的限制,可能会造成永久性设备损坏。

● 磁特性

除非另有说明,否则VCC=12V,Topr=25 。

1mT=10Gs

参数	符号	最小	典型	最大	单位
B工作点	Bop	10	30	60	Gs
B释放点	Brp	-60	-30	-10	Gs
磁滞	Bhys	-	60	-	Gs

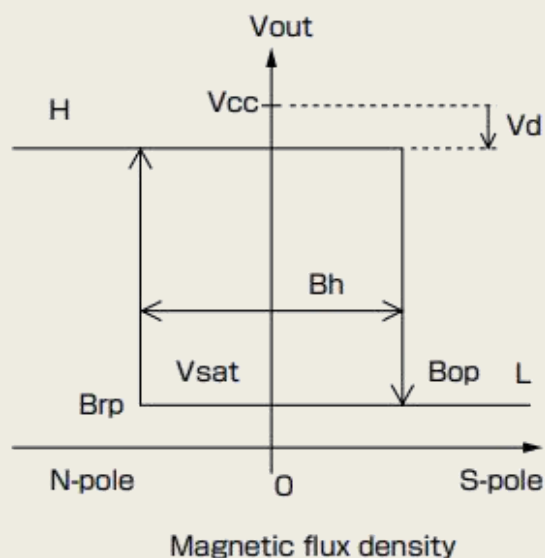
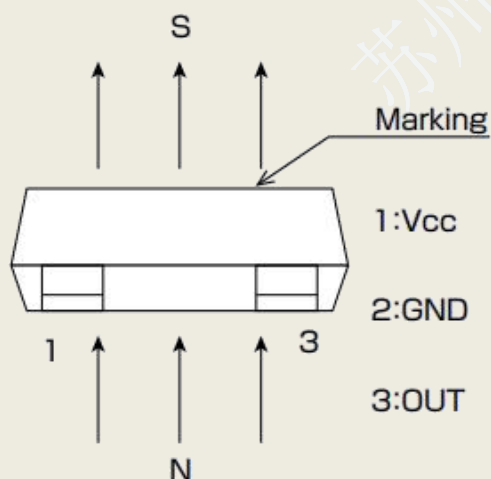
● 电气特性

除非另有说明，否则VCC=12V,Topr=25℃。

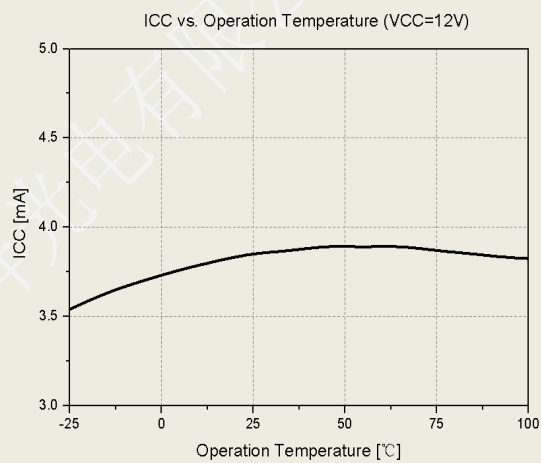
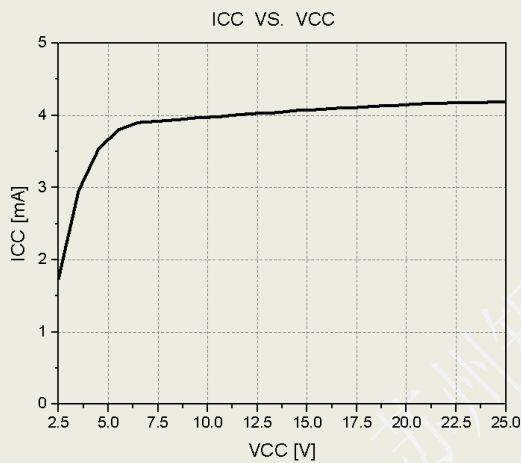
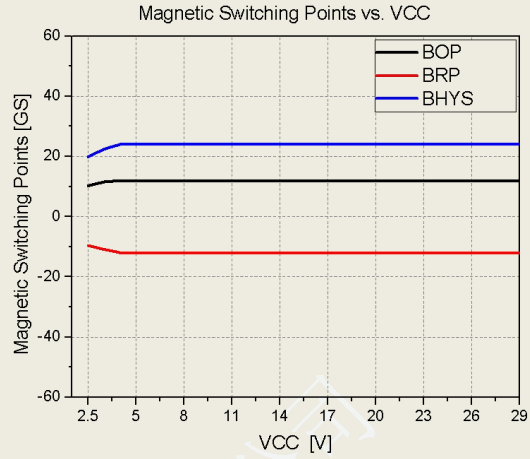
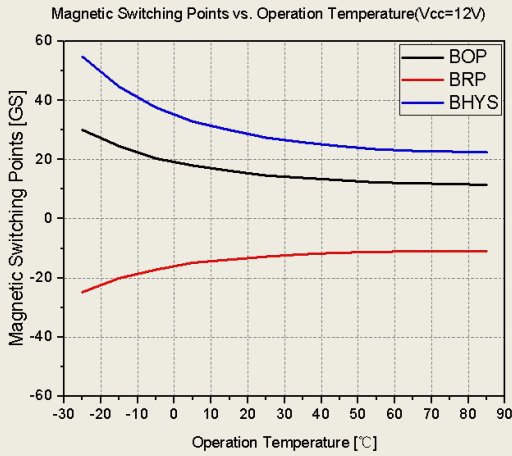
1mT=10Gs

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
电源电压	VCC	工作	2.3	12	33	V
电源电流	ICC	VCC=12V,输出=高	-	4	8	mA
输出漏电流	I _{LEAKAGE}		-	0.1	10	μA
输出饱和电压	VSAT	VCC=12V,输出=低			0.4	V
内置上拉电阻	RL		6		14	KΩ

● 闭锁式操作特性



● 典型特征



● 订购信息

产品	封装	标记 ID	包装类型	数量
WS331	TO92S	Wafer ID	Pack	300 pcs

● 文件履历表

版本	日期	描述
1.0	2021.06.07	初始版本发行
2.0	2022.03.12	格式重新排版，参数信息进一步完善
2.1	2023.06.13	修订内容（调整为中文版本）

苏州矩阵光电有限公司